(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 25. März 2004 (25.03.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/025831 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: H01G 4/40

H03H 7/01,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/002986

(22) Internationales Anmeldedatum:

9. September 2003 (09.09.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 41 674.5 9. September 2002 (09.09.2002)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von

US): EPCOS AG [DE/DE]; St. -Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ENGEL, Günter [AT/AT]; Kapellenweg 38, A-8430 Leibnitz (AT). FE-ICHTINGER, Thomas [AT/AT]; Tummelplatz 5, A-8010 Graz (AT). ORTNER, Markus [AT/AT]; Alberstrasse 4, A-8010 Graz (AT). SPERLICH, Reinhard [DE/DE]; Hölderlinstr.4, 83059 Kolbermoor (DE).

(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATEN-TANWALTSGESELLSCHAFT MBH; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

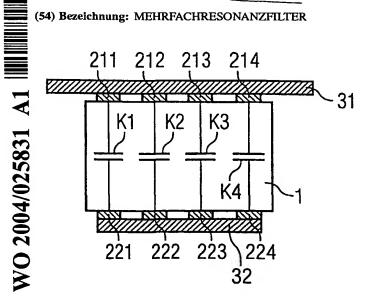
mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MULTIPLE RESONANCE FILTER

(54) Bezeichnung: MEHRFACHRESONANZFILTER



(57) Abstract: The invention relates to a multiple resonance filter which is used as a multilayer component and comprises at least three multilayer capacitors (K1, K2, K3, K4) that are disposed next to each other and are provided with at least two different capacities (C1, C2, C3), the two outer multilayer capacitors (K1, K4) having the same capacity (C1). The inventive filter has the advantage of providing improved insertion loss.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Mehrfachresonanzfilter als Vielschichtbauelement, enthaltend mindestens drei nebeneinanderliegende Vielschichtkondensatoren (K1, K2, K3, K4) mit mindestens zwei verschiedenen Kapazitäten (C1, C2, C3), wobei die beiden äußeren Vielschichtkondensatoren (K1, K4) dieselbe Kapazität (C1) aufweisen. Das Filter hat den Vorteil einer verbesserten Einfügedämpfung.

Best Available COPY

Beschreibung

Mehrfachresonanzfilter

5 Die Erfindung betrifft ein Mehrfachresonanzfilter, das mehrere Vielschichtkondensatoren enthält.

Aus der Druckschrift US 5898562 ist ein Mehrfachresonanzfilter bekannt, bei dem in einem Vielschichtbauelement zwei ne10 beneinanderliegende Vielschichtkondensatoren unterschiedlicher Kapazität integriert sind. Dieses Bauelement wird zur
Dämpfung von Störsignalen bei zwei durch die Kapazitäten der
beiden Kondensatoren vorgegebenen Frequenzen verwendet. Das
bekannte Bauelement hat den Nachteil, das die Dämpfung relativ schlechte Werte aufweist.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Mehrfachresonanzfilter anzugeben, das gute Dämpfungswerte aufweist.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Mehrfachresonanzfilter gemäß Patentanspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-

findung sind den weiteren Patentansprüchen zu entnehmen.

Es wird ein Mehrfachresonanzfilter angegeben, das ein elektrisches Vielschichtbauelement ist. Es enthält mindestens drei Vielschichtkondensatoren, die nebeneinander angeordnet sind. Die Vielschichtkondensatoren weisen dabei wenigstens zwei voneinander verschiedene Kapazitäten auf. Die beiden äußeren der in einer Reihe liegenden Vielschichtkondensatoren weisen dabei dieselbe Kapazität auf.

Durch den Aufbau des Mehrfachresonanzfilters mit nebeneinander in einer Reihe angeordneten Kondensatoren und durch das

35 Ausbilden von Kondensatoren gleicher Kapazität an den beiden
Rändern der Reihe kann erreicht werden, daß eine Entkopplung
der elektromagnetischen Felder im Filter stattfindet, wodurch

das Dämpfungsverhalten bei den einzelnen Resonanzfrequenzen des Filters verbessert wird.

Daraus ergibt sich der Vorteil, daß das Mehrfachresonanzfilter ein verbessertes Dämpfungsverhalten aufweist.

In einer vorteilhaften Ausführungsform des Mehrfachresonanzfilters sind die Vielschichtkondensatoren zueinander parallel geschaltet. Durch die Parallelschaltung können die Filtereigenschaften des Mehrfachresonanzfilters noch zusätzlich verbessert werden.

In einer Ausführungsform des Vielschichtbauelements ist ein Grundkörper vorgesehen, der einen Stapel aus übereinanderliegenden Dielektrikumschichten aufweist. Zwischen den Dielektrikumschichten aufweist. Zwischen den Dielektrikumschichten sind Elektrodenschichten angeordnet. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, daß zur Realisierung des Mehrfachresonanzfilters die an und für sich gut bekannte Technologie der Vielschichtkondensatoren genutzt werden kann.

Vielschichtkondensatoren sind im allgemeinen so aufgebaut, daß kammartig ineinandergreifende Elektrodenstapel im Inneren des Bauelements durch innenliegende Elektrodenschichten gebildet werden. Jeder Stapel von Innenelektroden ist gemeinsam mit einem Außenkontakt verbunden.

In einer Ausführungsform des Mehrfachresonanzfilters sind Außenkontakte der Elektrodenschichten an den Stirnseiten des Grundkörpers angeordnet.

In einer anderen Ausführungsform des Mehrfachresonanzfilters sind zu verschiedenen Kondensatoren gehörende Elektrodenschichten im Inneren des Grundkörpers miteinander verbunden. Dadurch kann in vorteilhafter Weise im Inneren des Grundkörpers, also im Inneren des Bauelements, eine Parallelschaltung der einzelnen Kondensatoren erfolgen.

20

25

30

10

In einer Ausführungsform des Mehrfachresonanzfilters verlaufen Elektrodenschichten in Längsrichtung des Grundkörpers. In einer anderen Ausführungsform verlaufen Elektrodenschichten quer zur Längsrichtung des Grundkörpers.

5

In einer Ausführungsform des Mehrfachresonanzfilters sind Außenkontakte der Elektrodenschichten an Seitenflächen des Grundkörpers angeordnet. Diese Ausführungsform des Filters erlaubt es, die Außenkontakte einzeln jedem einzelnen Kondensator des Vielschichtbauelements zuzuordnen und die gewünschte Verschaltung der Kondensatoren untereinander erst auf der mit dem Bauelement zu bestückenden Platine vorzunehmen. Dadurch wird die Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten des Bauelements vorteilhafterweise erhöht.

15

10

Insbesondere wird es dadurch ermöglicht, daß die Vielschichtkondensatoren außerhalb des Grundkörpers zueinander parallel geschaltet werden.

20

In einer Ausführungsform des Filters sind drei Vielschichtkondensatoren vorgesehen. In einer anderen Ausführungsform des Filters sind vier Vielschichtkondensatoren vorgesehen, wobei die beiden mittleren Vielschichtkondensatoren dieselbe Kapazität aufweisen.

25

30

35

In einer Ausführungsform des Filters bilden die Vielschichtkondensatoren zusammen mit den Induktivitäten der Elektrodenschichten bzw. zusammen mit den Induktivitäten der Zuleitungen zu den Elektrodenschichten LC-Filter. Durch die Hinzunahme von Induktivitäten zu dem Bauelement können die Filtereigenschaften des Bauelements weiter verbessert werden. Indem
der Hauptbeitrag der für das Filter benötigten Induktivitäten
von den Zuleitungen und den Elektrodenschichten herrührt, ist
es möglich, die Induktivität durch eine entsprechende Ausgestaltung der Elektrodenschichten bzw. der Zuleitungen zu den
Elektrodenschichten auf ein gewünschtes Maß einzustellen.

20

25

4

In einer Ausführungsform des Filters enthalten die Dielektrikumschichten eine Kondensatorkeramik auf der Basis von Bariumtitanat. Beispielsweise kommt als Dielektrikumschicht eine sogenannte "COG"-Keramik in Betracht. Ein solches Material wäre beispielsweise eine (Ba, Sm) NdTiO₆-Keramik. Es kommt aber auch eine "X7R"-Keramik in Betracht, beispielsweise dotiertes Bariumtitanat.

In einer anderen Ausführungsform enthalten die Dielektrikum-10 schichten ein Kondensatormaterial mit Varistoreffekt.

Als Keramikmaterial mit Varistoreffekt kommt beispielsweise ein Keramikmaterial auf der Basis von ZnO-Bi oder ZnO-Pr in Betracht. Solche Dielektrikumschichten haben den Vorteil, daß sie neben dem Kondensator noch als weiteres Bauelement einen Varistor in das Vielschichtbauelement integrieren.

Es ist darüber hinaus auch möglich, Kondensatorkeramiken und Keramiken mit Varistoreffekt innerhalb eines einzigen Bauelements miteinander zu kombinieren.

In einer Ausführungsform des Filters weist der Grundkörper eine Grundfläche auf, die kleiner als 6 mm² ist. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, daß der Platzbedarf des Bauelements sehr klein ist, was vorteilhaft für miniaturisierte Schaltungen ist.

In einer Ausführungsform des Filters weisen Elektrodenschichten, die zu den beiden äußeren Vielschichtkondensatoren gehören, gleiche Flächen auf. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, daß die Forderung nach gleichen Kapazitäten der äußeren Vielschichtkondensatoren durch gleiche Flächen besonders leicht realisiert werden kann.

35 Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen Figuren näher erläutert:

stellt ist.

5

Figur 1 zeigt ein Mehrfachresonanzfilter in einem schematischen Querschnitt.

Figur 2 zeigt die Einfügedämpfung des Bauelements aus Figur 1.

Figur 3 zeigt beispielhaft ein weiteres Mehrfachresonanzfilter in einer perspektivischen Außenansicht, wobei die Außenansicht mehrere Möglichkeiten für die innere Struktur umfaßt.

Figuren 31, 31A, 31D zeigen beispielhaft die innere Struktur für ein Bauelement mit einer äußeren Struktur gemäß Figur 3.

Figuren 32, 32A, 32D zeigen die innere Struktur eines weiteren Filters, dessen äußere Struktur in Figur 3 darge-

20 Figuren 33, 33A, 33D zeigen beispielhaft eine innere Struktur eines weiteren Bauelements, dessen äußere Struktur in Figur 3 gezeigt ist.

Figuren 34, 34A, 34D zeigen beispielhaft die innere 25 Struktur eines weiteren Filters, wobei dessen äußere Struktur durch Figur 3 gegeben ist.

Figur 4 zeigt beispielhaft die äußere Struktur für ein Filter, wobei diese Struktur für Filter, deren innere Struktur in den Figuren 41, 41A und 41D sowie in den Figuren 42, 42A und 42D gezeigt ist, gilt.

Figuren 41, 41A, 41D zeigen die innere Struktur für eine Ausführungsform des Filters, dessen äußere Struktur durch Figur 4 gegeben ist.

Figuren 42, 42A, 42D zeigen die innere Struktur für ein weiteres Filter, dessen äußere Struktur durch Figur 4 gegeben ist.

Figur 5 zeigt die äußere Struktur eines Filters beispielhaft in einer perspektivischen Ansicht, wobei die äußere Struktur für eine Vielzahl von inneren Strukturen gültig ist.

Figuren 51, 51A, 51D zeigen die innere Struktur eines

10 Filters, dessen äußere Struktur durch Figur 5 gegeben ist.

Figuren 52, 52A, 52D zeigen die innere Struktur eines weiteren Filters, dessen äußere Struktur durch Figur 5 gegeben ist.

15

Figur 1 zeigt ein Mehrfachresonanzfilter, das einen Grundkörper 1 aufweist. Im Inneren des Grundkörpers 1 sind Kondensatoren K1, K2, K3, K4 nebeneinanderliegend in einer Reihe angeordnet. Jeder der Kondensatoren K1, K2, K3, K4 ist jeweils 20 mit einem ersten Kondensatoranschluß 211, 212, 213, 214 und mit einem zweiten Kondensatoranschluß 221, 222, 223, 224 verbunden. Die jeweils zu einem Kondensator K1, K2, K3, K4 gehörenden ersten Kondensatoranschlüsse 211, 212, 213, 214 sind durch einen Kontakt 31 miteinander elektrisch leitend verbunden. Die zu jeweils einem Kondensator K1, K2, K3, K4 gehören-25 den zweiten Kondensatoranschlüsse 221, 222, 223, 224 sind durch einen Kontakt 32 elektrisch leitend miteinander verbunden. Durch die Kontakte 31, 32 wird eine parallele Schaltung der Kondensatoren K1, K2, K3, K4 realisiert. Die Kondensatoren K1, K2, K3, K4 sind hinsichtlich ihrer Kapazität C1, C2, 30 C3 so ausgeführt, daß die Kondensatoren K1 und K4 die Kapazität C1 aufweisen, also in der Kapazität gleich sind. Die Kondensatoren K2 und K3 weisen die Kapazität C2 und C3 auf. Die Kapazitäten C2, C3 können gleich oder auch voneinander verschieden sein. 35

Figur 2 zeigt das Dämpfungsverhalten des Mehrfachresonanzfilter aus Figur 1 für den Fall, daß die beiden Kondensatoren K2 und K3 aus Figur 1 die gleiche Kapazität C2 aufweisen. In Figur 2 ist die Dämpfung S in der Einheit Dezibel aufgetragen über die Frequenz f, gemessen in GHz, eines elektrischen Signals, welches an das Filter angelegt wurde. Es ist in Figur 2 zu erkennen, daß bei den Resonanzfrequenzen f1 und f2 eine sehr hohe Dämpfung kleiner als -40 dB gemessen wurde. Dies zeigt, daß das Mehrfachresonanzfilter, welches in dieser Anmeldung beschrieben wird, sehr gute Dämpfungseigenschaften hat. Die beiden Resonanzfrequenzen f1, f2, bei denen die Minima in der Dämpfungskurve auftreten, sind dabei durch die Kapazitäten C1 und C2 der Kondensatoren K1, K2, K3, K4 gegeben.

15

20

10

Figur 3 zeigt die äußere Struktur eines Mehrfachresonanzfilters, bei dem die Außenkontakte 71, 72 an den Stirnseiten des Grundkörpers 1 kappenförmig angeordnet sind. Die kappenförmige Anordnung der Außenkontakte 71, 72 hat den Vorteil, daß das Bauelement für die Oberflächenmontagetechnik geeignet ist. Dabei ist der Außenkontakt 71 an der Stirnfläche 81 des Grundkörpers 1 und der Außenkontakt 72 an der Stirnseite 82 des Grundkörpers 1 aufgebracht.

Die Figur 31 zeigt einen Schnitt entlang der Linie C-C von Figur 3. Es sind die übereinanderliegenden Dielektrikumschichten 4 zu erkennen, die durch Elektrodenschichten 52, 62 voneinander getrennt sind. Da in dem Beispiel von Figur 31 die Kontaktierung der Elektrodenschichten 52, 62 über die Stirnseiten des Grundkörpers erfolgt, sind in Figur 31 die Elektrodenschichten 52, 62 nicht bis zum äußeren seitlichen Rand des Grundkörpers hinausgezogen. Die Elektrodenschichten 52 gehören dabei zu einem Vielschichtkondensator, wobei die Elektroden 52 alle miteinander parallel verschaltet sind. Die Elektrodenschichten 62, die ihrerseits ebenso wie die Elektrodenschichten 52 übereinandergestapelt sind, gehören ebenfalls zu demselben Vielschichtkondensator wie die Elektroden-

schichten 52 und sind seitlich zu den Elektrodenschichten 52 versetzt angeordnet. Aus Figur 31 geht auch das kammartige Ineinandergreifen der Elektrodenschichten 52 und 62 hervor. In Figur 31 sind die Elektrodenschichten 52 durch durchgezogene Striche gekennzeichnet, während die Elektrodenschichten 62 durch jeweils eine gepunktete Linie gekennzeichnet sind. Dies gilt in analoger Art und Weise für die Figuren 31D, 32, 32D, 33, 33D, 34, 34D, 41, 41D, 42, 42D, 51, 51D, 52 und 52D.

- 10 Die hier beschriebenen Vielschichtkondensatoren sind prinzipiell alle so aufgebaut, wie in Figur 31 gezeigt. Dies gilt insbesondere für das kammartige Ineinandergreifen der Elektrodenschichten.
- Figur 31A zeigt einen Schnitt entlang der Linie A-A aus Figur 15 31. Es ist erkennbar, daß im Inneren des Vielschichtbauelements drei Vielschichtkondensatoren K1, K2, K3 angeordnet sind. Die beiden äußeren Kondensatoren K1, K3 weisen dabei Elektrodenschichten 51, 53 bzw. 61, 63 auf, die gleiche Flä-20 chen haben. Daher haben die Kondensatoren K1 und K3 dieselbe Kapazität. Der Vielschichtkondensator K2, der in der Mitte der Reihe von Kondensatoren K1, K2, K3 angeordnet ist, weist dagegen Elektrodenschichten 52, 62 auf, welche größer sind als die Elektrodenschichten 51, 61, 53, 63. Entsprechend hat der Kondensator K2 eine größere Kapazität als die Kondensato-25 ren K1 und K3. In Figur 31A sind die in der Schnittebene liegenden Elektroden als schraffierte Flächen, welche von durchgezogenen Linien begrenzt sind, dargestellt. In einer darüber- oder darunterliegenden Ebene angeordnete Elektroden-30 schichten, dies sind insbesondere die Elektrodenschichten 61, 62, 63 sowie das innere Verbindungselement 92, sind durch Flächen, die von gestrichelten Linien begrenzt werden, dargestellt. In Figur 31A ist gezeigt, daß die Elektrodenschichten 51, 52, 53 durch ein inneres Verbindungselement 91 miteinander verbunden sind. Das innere Verbindungselement 91 kann in 35 derselben Art und Weise wie die Elektrodenschichten 51, 52, 53 gebildet sein. Es kann beispielsweise in Vielschichttech-

nik aus einer metallhaltigen Paste gebildet sein. Das Verbindungselement 91 ist unmittelbar mit dem Außenkontakt 72 kontaktiert. Entsprechend gibt es für die Elektrodenschichten 61, 62, 63 ein inneres Verbindungselement 92, das diese Elektrodenschichten 61, 62, 63 miteinander elektrisch leitend verbindet. Das innere Verbindungselement 92 ist mit dem Außenkontakt 71 elektrisch leitend verbunden. Dadurch wird eine innere Parallelschaltung der Kondensatoren K1, K2, K3 realisiert.

10

Figur 31D zeigt einen Schnitt entlang der Linie D-D aus Figur 31A. Es ist in einer analogen Darstellung wie in Figur 31 zu erkennen, daß es für jeden Kondensator übereinandergestapelte Elektrodenschichten 51, 52, 53 (für den ersten Kontakt der 15 Kondensatoren, mit durchgezogenen Linien gekennzeichnet) bzw. übereinandergestapelte Elektrodenschichten 61, 62, 63 (für den zweiten Kontakt des jeweiligen Kondensators, mit gestrichelten Linien gekennzeichnet) gibt. Die übereinandergestapelten Elektrodenschichten 51, 61 sowie 52, 62 und 53, 63 20 bilden jeweils einen Vielschichtkondensator K1, K2, K3. Es sind ferner die Verbindungselemente 91, 92 in Figur 31D gezeigt. Es ist dabei zu beachten, daß in der Darstellung von Figur 31D auch die Verbindungselemente 91, 92 in einer Vielzahl als Stapel von Verbindungselementen 91, 92 übereinander-25 gestapelt dargestellt sind.

Figur 32 zeigt den inneren Aufbau eines Mehrfachresonanzfilters entsprechend Figur 31, jedoch mit dem Unterschied, daß nur die inneren Verbindungselemente 91, 92 dargestellt sind.

30 Die inneren Verbindungselemente 91 sind als gestrichelte Linien dargestellt. Die inneren Verbindungselemente 92 sind als durchgezogene Linien dargestellt. Figur 32A zeigt einen Schnitt entlang der Linie A-A aus Figur 32. Es ist in analoger Art und Weise wie in Figur 31A zu erkennen, daß das Mehrfachresonanzfilter aus vier Kondensatoren K1, K2, K3, K4 besteht, welche in einer zu Figur 31A, Figur 31D und Figur 31 analogen Art und Weise aufgebaut sind. Der Unterschied zwi-

schen den Figuren 32, 32A und 32D zu den Figuren 31, Figur 31A und Figur 31D besteht lediglich in der Anzahl von Kondensatoren. In Figur 32A ist noch eine Zuleitung 110 bzw. eine Zuleitung 111 gezeigt, woraus hervorgeht, daß mit Hilfe der Zuleitungen 110, 111 Induktivitäten in das Bauelement integriert werden können. Dabei werden die Induktivitäten über die Länge der Zuleitungen 110, 111 bestimmt. Die Zuleitungen 110, 111 haben dabei die Aufgabe der inneren Verbindungselemente 91, 92. Es ist dabei zu beachten, daß die Induktivitäten den des Bauelements auch noch von den Formen und Flächen der Elektrodenschichten 51, 52, 53, 54 bzw. 61, 62, 63, 64, wie sie in Figur 32A als Draufsicht und in Figur 32D im Querschnitt dargestellt sind, abhängen.

15 Die Figur 32D zeigt einen Schnitt entlang der Linie D-D von Figur 32A. Es sind noch mal vier übereinandergestapelte Elektrodenschichten 51, 61 bzw. 52, 62 bzw. 53, 63 und 54, 64 dargestellt. Der Aufbau ist wieder entsprechend dem Aufbau von Figur 31D dargestellt.

20

Die Figuren 33, 33A und 33D zeigen ein Mehrfachresonanzfilter entsprechend den Figuren 31, 31A, 31D bzw. entsprechend den Figuren 32, 32A, 32D mit dem Unterschied, daß die Elektrodenschichten 51, 52, 53 bzw. 61, 62, 63 bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 33, 33A, 33D nicht quer zur Längs-25 richtung des Grundkörpers, sondern in dieser Längsrichtung verlaufen. Dementsprechend ist die Länge des inneren Verbindungselements 91, 92 verkürzt, wobei jedoch die Länge der Elektrodenschichten 51, 52, 53 bzw. 61, 62, 63 vergrößert 30 ist. Die verschiedenen Ausführungsbeispiele hinsichtlich der Orientierung der Elektrodenschichten 51, 52, 53, 54 bzw. 61, 62, 63, 64 zeigen, daß man bei der Gestaltung der Kapazitäten bzw. Induktivitäten für das Mehrfachresonanzfilter einen großen Spielraum hat. Ansonsten entspricht die Darstellung der Figuren 33, 33A, 33D den Beispielen aus den Figuren 31, 31A, 35 31D.

Die Figuren 34, 34A, 34D zeigen eine Ausführungsform des Mehrfachresonanzfilters entsprechend den Figuren 33, 33A, 33D mit dem Unterschied, daß vier anstelle von drei Vielschichtkondensatoren in dem Bauelement ausgebildet sind.

5

10

Figur 4 zeigt eine äußere Struktur für eine Gruppe von Mehrfachresonanzfiltern, wobei beispielhaft für diese Gruppe in den Figuren 41, 41A, 41D sowie 42, 42A, 42D Ausführungsformen für die Innenstruktur gezeigt sind. Figur 4 zeigt das Mehrfachresonanzfilter mit dem Grundkörper 1, an dessen Seitenflächen 101, 102 Außenkontakte 71, 72 angeordnet sind.

Figur 41 zeigt einen Schnitt entlang der Linie C-C von Figur 4. Es sind analog zur Darstellung in den Figuren 31, 32, 33, 15 34 Stapel von übereinanderliegen Dielektrikumschichten 4 sowie Elektrodenschichten 52, 62 dargestellt. Die in den Figuren 41, 41A und 41D gezeigten Ansichten des Mehrfachresonanzfilters unterscheiden sich von der Darstellung in den Figuren 31, 31A, 31D lediglich dadurch, daß die Kontaktierung der Kondensatoren nicht von den Stirnflächen des Grundkörpers, 20 sondern von den Seitenflächen des Grundkörpers her erfolgt. Entsprechend ist die Länge der Zuleitungen 110, 111 z. B. bei den Figuren 41, 41A, 41D verkürzt, weswegen bei dieser Ausführungsform die Induktivität des Bauelements verringert ist. 25 Die Figuren 41A, 41D zeigen jeweils Schnittansichten, wie sie in analoger Weise den Figuren 31A, 31D entsprechen.

Die Figuren 42, 42A, 42D zeigen eine Ausführungsform für das Mehrfachresonanzfilter entsprechend den Figuren 41, 41A, 41D, 30 mit dem Unterschied, daß eine Vielzahl von vier Kondensatoren K1, K2, K3, K4 anstelle von drei Kondensatoren im Inneren des Bauelements ausgebildet ist. Ansonsten entsprechen die Darstellungen in den Figuren 42, 42A, 42D den Darstellungen in den Figuren 41, 41A, 41D.

35

Figur 5 zeigt eine äußere Struktur für ein Mehrfachresonanzfilter, wobei ein Grundkörper 1 vorgesehen ist. Der Grundkör-

12

per 1 weist Stirnseiten 81, 82 auf. Der Grundkörper 1 weist auch Seitenflächen 101, 102 auf. An jeder Seitenfläche 101, 102 sind jeweils vier Außenkontakte 711, 712, 713, 714 bzw. 721, 722, 723, 724 angeordnet. Dabei gehört jedes gegenüberliegende Paar von Außenkontakten 711, 721 bzw. 712, 722 bzw. 713, 723 bzw. 714, 724 zu einem Kondensator im Inneren des Grundkörpers 1.

Figur 51 zeigt einen Schnitt entlang der Linie C-C von Figur 5. Die Darstellung in den Figuren 51, 51A, 51D entspricht der Darstellung in den Figuren 41, 41A, 41D, mit dem Unterschied, daß hier die Verbindungselemente 91, 92 fehlen, da jeder einzelne Kondensator K1, K2, K3 einzeln mit Außenkontakten 711, 712, 713, 714 bzw. 721, 722, 723, 724 (vergleiche Figur 51A) verbunden ist. Im übrigen entspricht die Darstellung in den Figuren 51, 51A, 51D der Darstellung in den Figuren 41, 41A, 41D.

Die Figuren 52, 52A, 52D zeigen die innere Struktur eines

Mehrfachresonanzfilters, wie es mit einer Außenstruktur entsprechend Figur 5 ausgebildet werden kann. Die Darstellung in den Figuren 52, 52A, 52D entspricht der Darstellung in den Figuren 51, 51A, 51D, mit dem Unterschied, daß vier Vielschichtkondensatoren K1, K2, K3, K4 anstelle von drei Kondensatoren K1, K2, K3 entlang des Bauelements angeordnet sind. Indem die beiden mittleren Kondensatoren K2, K3 hinsichtlich ihrer Elektrodenschichten 52, 53 bzw. 62, 63 so ausgebildet sind, daß sie dieselbe Kapazität C2 aufweisen, kann das Dämpfungsverhalten bei der zweiten Resonanzfrequenz f2 noch mal deutlich verbessert werden.

Die Erfindung beschränkt sich nicht auf Mehrfachresonanzfilter mit zwei Filterfrequenzen, sondern kann auf Mehrfachresonanzfilter mit einer Vielzahl verschiedener Resonanzfrequenzen angewendet werden.

Bezugszeichenliste

- 1 Grundkörper
- 211, 212, 213, 214 erste Kondensatoranschlüsse
- 5 221, 222, 223, 223 zweite Kondensatoranschlüsse
 - 31, 32 Kontakt
 - 4 Dielektrikumschicht
 - 51, 52, 53, 54 Elektrodenschicht
 - 61, 62, 63, 64 Elektrodenschicht
- 10 711, 712, 713, 714 Außenkontakt
 - 721, 722, 723, 724 Außenkontakt
 - 71, 72 Außenkontakt
 - 81, 82 Stirnseite
 - 91, 92 inneres Verbindungselement
- 15 101, 102 Seitenfläche
 - 110, 111 Zuleitung
 - C1, C2, C3 Kapazität
 - K1, K2, K3, K4 Kondensator
 - S Einfügedämpfung
- 20 f Frequenz
 - f1, f2 Resonanzfrequenz

Patentansprüche

- 1. Mehrfachresonanzfilter als Vielschichtbauelement,
- enthaltend mindestens drei nebeneinanderliegende Vielschichtkondensatoren (K1, K2, K3, K4) mit mindestens zwei verschiedenen Kapazitäten (C1, C2, C3),
- wobei die beiden äußeren Vielschichtkondensatoren (K1, K4) dieselbe Kapazität (C1) aufweisen.
- 10 2. Filter nach Anspruch 1,
 - bei dem die Vielschichtkondensatoren (K1, K2, K3, K4) zu- einander parallel geschaltet sind.
 - 3. Filter nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
- das einen Grundkörper (1) aufweist und das einen Stapel aus übereinanderliegenden Dielektrikumschichten (4) mit dazwischenliegenden Elektrodenschichten (51, 52, 53, 54; 61, 62, 63, 64) aufweist.
- 20 4. Filter nach Anspruch 3,
 - bei dem Außenkontakte (71, 72) der Elektrodenschichten (51, 52, 53, 54; 61, 62, 63, 64) an den Stirnseiten (81, 82) des Grundkörpers (1) angeordnet sind.
- 25 5. Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 4,
 - bei dem zu verschiedenen Kondensatoren (K1, K2, K3, K4) gehörende Elektrodenschichten (51, 52, 53, 54; 61, 62, 63, 64) im Inneren des Grundkörpers (1) miteinander verbunden sind.

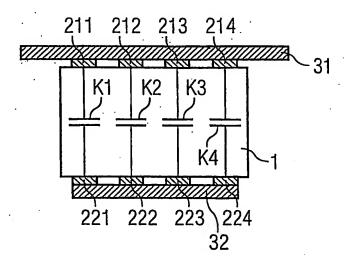
- 6. Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
- bei dem Elektrodenschichten (51, 52, 53, 54; 61, 62, 63, 64) in Längsrichtung des Grundkörpers (1) verlaufen.
- 35 7. Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
 - bei dem Elektrodenschichten (51, 52, 53, 54; 61, 62, 63, 64) quer zur Längsrichtung des Grundkörpers (1) verlaufen.

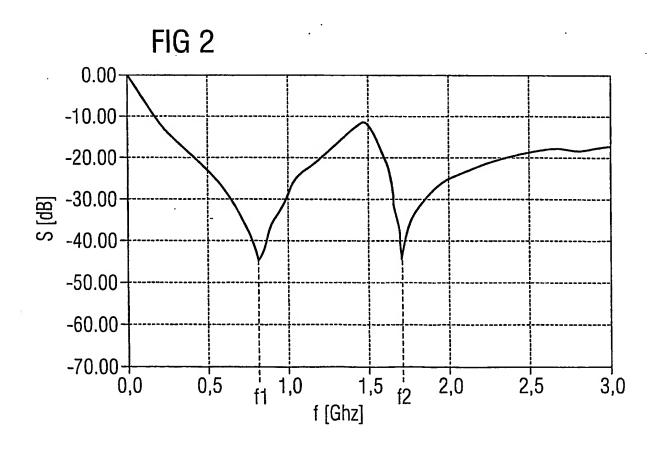
35

- 8. Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
- bei dem Außenelektroden (711, 712, 713, 714; 721, 722, 723, 724, 71, 72) der Elektrodenschichten (51, 52, 53, 54; 61,
- 5 62, 63, 64) an Seitenflächen (101, 102) des Grundkörpers (1) angeordnet sind.
 - 9. Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
- bei dem die Vielschichtkondensatoren (K1, K2, K3, K4) au-10 Berhalb des Grundkörpers (1) zueinander parallel geschaltet sind.
 - 10. Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
- bei dem drei Vielschichtkondensatoren (K1, K2, K3) vorgesehen sind.
 - 11. Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
 - bei dem vier Vielschichtkondensatoren (K1, K2, K3, K4) vorgesehen sind, wobei die beiden mittleren Vielschichtkondensatoren (K2, K3) dieselbe Kapazität (C2) aufweisen.
 - 12. Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
 - bei dem die Vielschichtkondensatoren (K1, K2, K3, K4) zusammen mit Induktivitäten der Elektrodenschichten (51, 52,
- 25 53, 54; 61, 62, 63, 64) und der Zuleitungen (110, 111) LC-Filter bilden.
 - 13. Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 12,
- bei dem die Dielektrikumschichten (4) eine Kondensatorkera-30 mik auf der Basis von Bariumtitanat enthalten.
 - 14. Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 13,
 - bei dem die Elektrodenschichten ein Keramikmaterial mit Varistoreffekt enthalten.
 - 15. Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 14,

- bei dem der Grundkörper (1) eine Grundfläche aufweist, die kleiner als 6 mm^2 ist.
- 16. Filter nach einem Ansprüche 3 bis 15,
- bei dem Elektrodenschichten (51, 52, 53, 54; 61, 62, 63,
 - 64), die zu den beiden äußeren Vielschichtkondensatoren
 - (K1, K4) gehören, gleiche Flächen aufweisen.

FIG 1





2/9

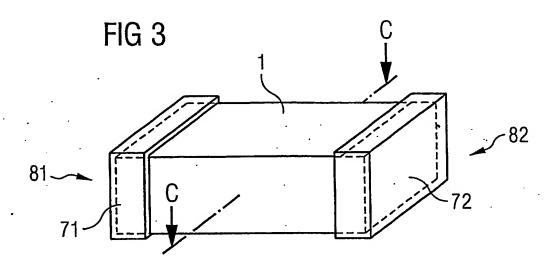


FIG 31

A

B

62 4 52

A

A

A

A

FIG 31A

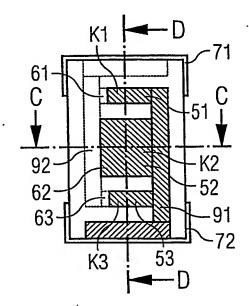


FIG 31D

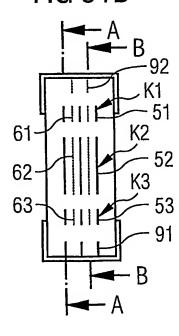


FIG 32

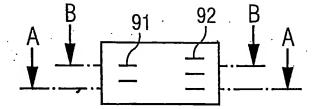


FIG 32A

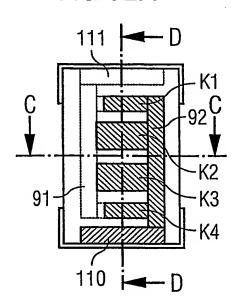
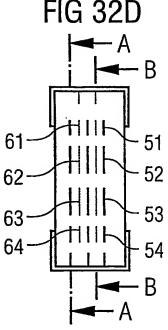


FIG 32D



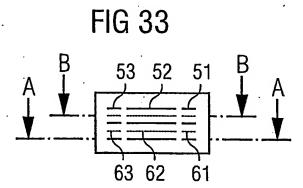


FIG 33A

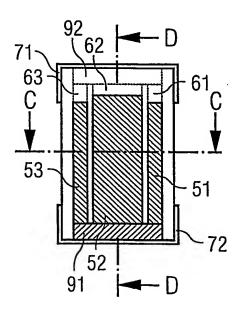


FIG 33D

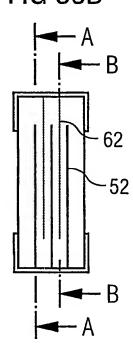


FIG 34

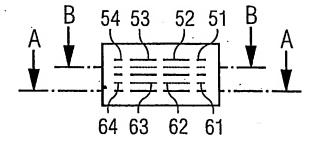


FIG 34A

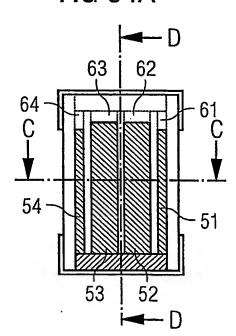
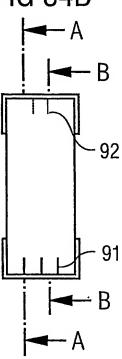


FIG 34D



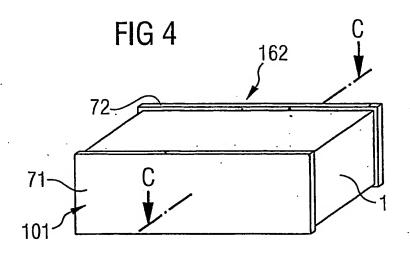


FIG 41

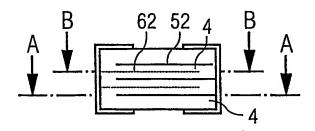


FIG 41A

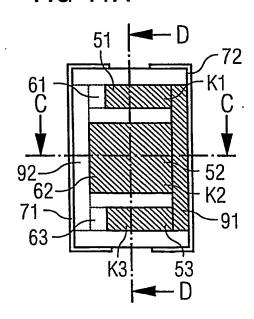
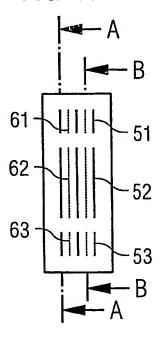
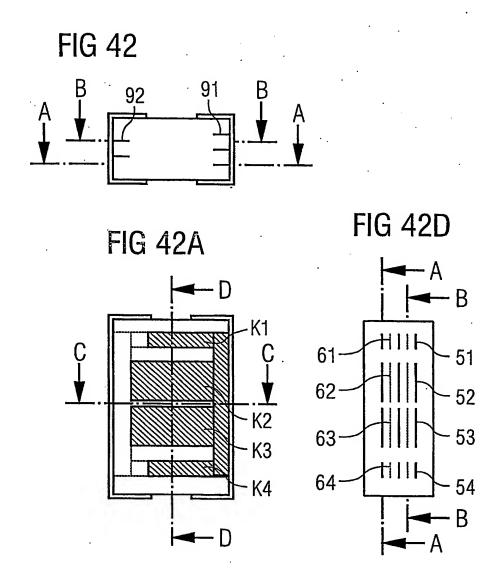
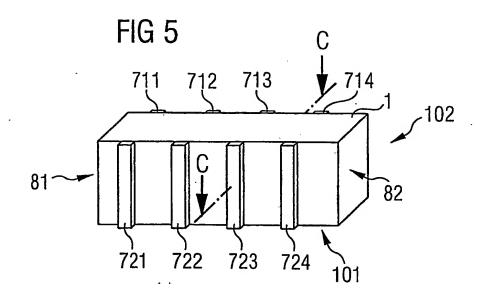
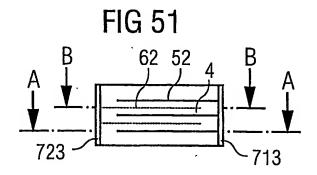


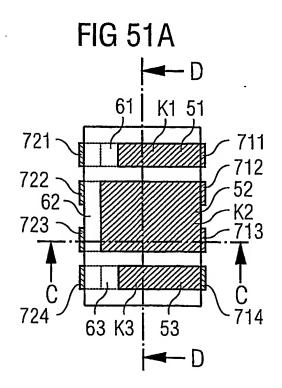
FIG 41D











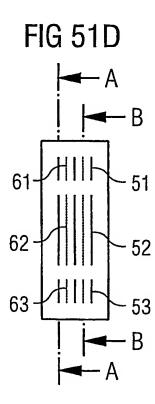


FIG 52

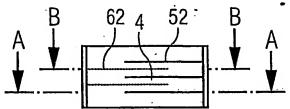


FIG 52A

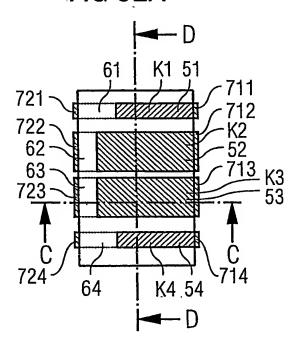
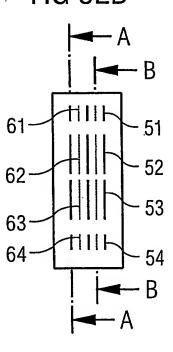


FIG 52D



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

pplication No 03/02986

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H03H7/01 H01G4/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\label{lem:minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \begin{tabular}{ll} IPC 7 & H03H & H01G \end{tabular}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X	US 6 304 156 B1 (KUSHITANI HIROSHI ET AL) 16 October 2001 (2001-10-16) figures 12,13 table 1 column 16, line 28	1-16	
	column 21, line 1		
X	EP 1 215 748 A (MURATA MANUFACTURING CO) 19 June 2002 (2002-06-19) figures 1-3 column 5, line 35-37 column 6, line 29-31,34,35,41-44	1–16	
A	US 6 088 214 A (DENDY DEBORAH SUE ET AL) 11 July 2000 (2000-07-11) figure 1 abstract	1-16	

document published after the International filing date forthy date and not in conflict with the application but it to understand the principle or theory underlying the nition ment of particular relevance; the claimed invention not be considered novel or cannot be considered to live an inventive step when the document is taken alone ment of particular relevance; the claimed invention not be considered to involve an inventive step when the ument is combined with one or more other such doculats, such combination being obvious to a person skilled e art.
24/02/2004 orized officer Plathner, B-D

Patent family members are listed in annex.

X Further documents are listed in the continuation of box C.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No
PCT/L 3/02986

		PCT/L 3/02986
	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1 079 520 A (MURATA MANUFACTURING CO) 28 February 2001 (2001-02-28) figures 1-3 abstract	1-16
	•.	
	•	·
•		÷
•		
		-
	.	

A HORAL OFWIGHT INFLORE

nforman on patent family members

PCT/s 3/02986

Patent document		Publication		Patent family	Publication
ated in search report		date		member(s)	date
US 6304156	B1	16-10-2001	US	6020799 A	01-02-2000
			DE	69426283 D1	21-12-2000
			DE	69426283 T2	15-03-2001
			DE	69432058 D1	27-02-2003
			DE	69432058 T2	22-01-2004
			DE	69432059 D1	27-02-2003
			DE	69432059 T2	20-11-2003
			DE	69432060 D1	27-02-2003
•			DE	69432060 T2	20-11-2003
			ĐĒ	69433305 D1	11-12-2003
**			EP	0641035 A2	01-03-1995
•			EP	0917232 A2	19-05-1999
			EP	0917232 A2	19-05-1999
			EP	0917234 A2	19-05-1999
•			EP	0917235 A2	19-05-1999
			JP	7312503 A	28-11-1995
			JP	2004007738 A	08-01-2004
			JP	2004007739 A	08-01-2004
		•	US	5719539 A	17-02-1998
EP 1215748	Α	19-06-2002	JP	3031178 B2	10-04-2000
			JP	8097743 A	12-04-1996
			EP	1215748 A1	19-06-2002
			EP	1331687 A1	30-07-2003
			EP	1378958 A1	07-01-2004
			EP	1113519 A1	04-07-2001
			ĒΡ	1113520 A1	04-07-2001
			ĒΡ	1113521 A1	04-07-2001
			· EP	1111708 A1	27-06-2001
			DE	1215748 T1	28-11-2002
•			DE	29522384 U1	24-10-2002
			DE	69521860 D1	30-08-2001
			DE	69521860 T2	11-04-2002
			DE	69531368 D1	28-08-2003
			DE	69531370 D1	28-08-2003
			DE	69531371 D1	28-08-2003
			DE	69531375 D1	28-08-2003
			EP	0704925 A1	03-04-1996
			US	5990732 A	23-11-1999
			US	5783976 A	21-07-1998
US 6088214	Α	11-07-2000	AU	4319999 A	20-12-1999
			WO	9963558 A1	09-12-1999
EP 1079520	A	28-02-2001	JP	2001136045 A	18-05-2001
		_	CN	1285655 A	28-02-2001
			EP	1079520 A2	28-02-2001
			FF	10/35/N W/	20-07-7001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internal des Aktenzeichen PCT/ 3/02986

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H03H7/01 H01G4/40

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H03H H01G

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Namé der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 304 156 B1 (KUSHITANI HIROSHI ET AL) 16. Oktober 2001 (2001-10-16) Abbildungen 12,13 Tabelle 1 Spalte 16, Zeile 28 Spalte 21, Zeile 1	1-16
X	EP 1 215 748 A (MURATA MANUFACTURING CO) 19. Juni 2002 (2002-06-19) Abbildungen 1-3 Spalte 5, Zeile 35-37 Spalte 6, Zeile 29-31,34,35,41-44	1-16
A	US 6 088 214 A (DENDY DEBORAH SUE ET AL) 11. Juli 2000 (2000-07-11) Abbildung 1 Zusammenfassung	1-16

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 16. Februar 2004 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 24/02/2004 Bevollmächtigter Bediensteter Plathner, B-D	ausgeführt) "O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 *T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *8' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,		
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	

Siehe Anhang Patentfamilie

entnehmen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internation les Aktenzeichen
PCT/L 3/02986

	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	EP 1 079 520 A (MURATA MANUFACTURING CO) 28. Februar 2001 (2001-02-28) Abbildungen 1-3 Zusammenfassung	1-16	
			
	•		
	·		
	·		

IIA I FIZIAV I CIAVEFIZ IZFOLIFIZOLIFIADEIZIOLI

elben Patentfamilie gehören

Angaben zu Veröffentlichungen, d

PCT/ 3/02986 Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentiamilie Veröffentlichung US **B1** 16-10-2001 6020799 A US 6304156 01-02-2000 DE 69426283 D1 21-12-2000 DE 69426283 T2 15-03-2001 DE 69432058 D1 27-02-2003 69432058 T2 DE 22-01-2004 69432059 D1 DE 27-02-2003 DE 69432059 T2 20-11-2003 DE 69432060 D1 27-02-2003 DE 69432060 T2 20-11-2003 69433305 D1 DE 11-12-2003 EP 0641035 A2 01-03-1995 EP 0917232 A2 19-05-1999 EP 0917233 A2 19-05-1999 EP 0917234 A2 19-05-1999 EP 0917235 A2 19-05-1999 JP 7312503 A 28-11-1995 JP 2004007738 A 08-01-2004 2004007739 A JP 08-01-2004 US 5719539 A 17-02-1998 Α JP EP 1215748 19-06-2002 3031178 B2 10-04-2000 JP 8097743 A 12-04-1996 EP 1215748 A1 19-06-2002 EP 1331687 A1 30-07-2003 EP 1378958 A1 07-01-2004 EP 1113519 A1 04-07-2001 EP 1113520 A1 04-07-2001 EP 1113521 A1 04-07-2001 EP 1111708 A1 27-06-2001 DE 1215748 T1 28-11-2002 DE 29522384 U1 24-10-2002 DE 69521860 D1 30-08-2001 DE 69521860 T2 11-04-2002 DE 69531368 D1 28-08-2003 DE 69531370 D1 28-08-2003 DE 69531371 D1 28-08-2003 DE 69531375 D1 28-08-2003 EP 0704925 A1 03-04-1996 US 5990732 A 23-11-1999 US 5783976 A 21-07-1998 US 6088214 Α 11-07-2000 AU 4319999 A 20-12-1999 WO 9963558 A1 09-12-1999 EP 1079520 18-05-2001 Α 28-02-2001 JP 2001136045 A CN 1285655 A 28-02-2001 EP 1079520 A2 28-02-2001 25-06-2002 US 6411178 B1

Internat

s Aktenzeichen

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
\square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHED.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.